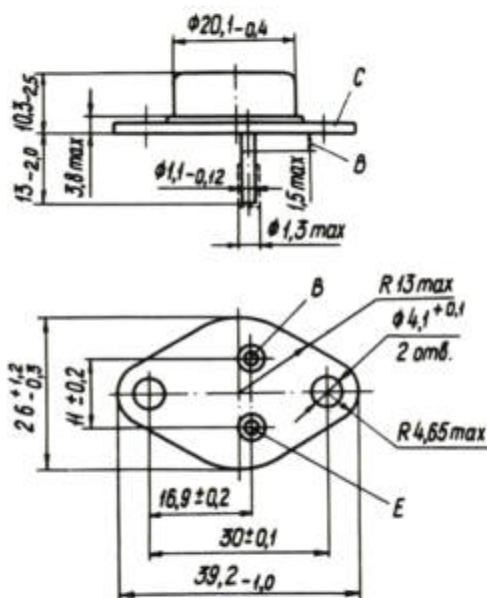


KT844A



БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ
HIGH POWER MEDIUM FREQUENCY



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n переключающий транзистор KT844A предназначен для работы в импульсных схемах аппаратуры широкого применения.

Оформление - в металлическом корпусе.

Диапазон допустимых рабочих температур от -45 до +100°С.

GENERAL DESCRIPTION

The KT844A transistors are Silicon planar-epitaxial n-p-n switching-type transistors designed for use in pulse circuits of equipment in a wide range of applications.

The devices are encapsulated in metal cases.

Allowable operating temperatures: -45 to +100°С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

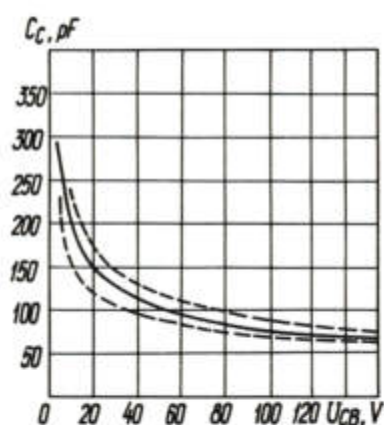
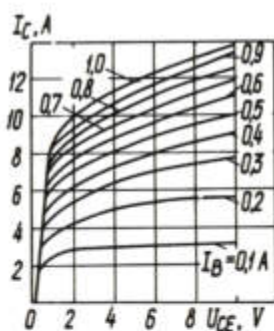
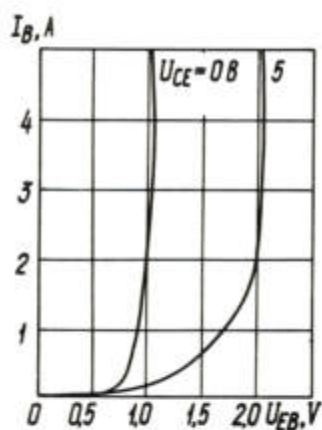
$U_{CER\ max}$ ($R_{BE} = 10\ \Omega$)	250 V
$U_{EB\ max}$	4 V
$I_C\ max$	10 A
$I_{CM\ max}$	20 A
$I_B\ max$	4 A
$I_{BM\ max}$	7 A
$P_C\ max^*$ ($t_{case} \leq 50^\circ C$)	50 W
$t_j\ max$	175°С

* При $t_{case} > 50^\circ C \Rightarrow P_C\ max = \frac{t_j\ max - t_{case}}{R_{thjc}}$

KT844A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions			
		$U_{CE}; U_{EB}^*$ V	$I_C; I_B^*$ A	R_{BE}^* Ω	f , MHz
$U_{(L)CEO}$, V	>250		0,1		
I_{CER} , mA	<3	250		10	
I_{EBO} , mA	<20	4^*			
h_{21E}	10 - 50	3	6		
$ h_{21e} $	$>2,4$	10	0,5		3
$U_{CE sat}$, V	$<2,5$		6; $0,6^*$		
$U_{BE sat}$, V	$<2,5$		6; $0,6^*$		
C_c , pF	160 - 300	10			1
t_f , μs	$<0,3$	100	6		
t_s , μs	<2	100	6		
t_r , μs	$<0,3$	100	6		

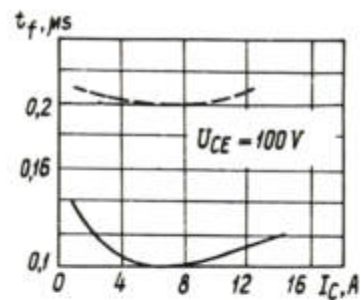
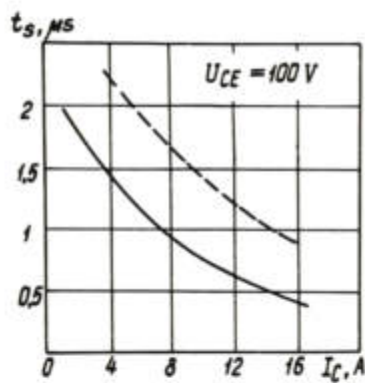
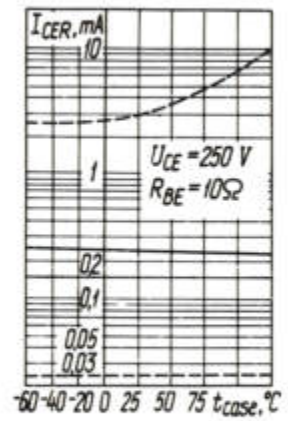
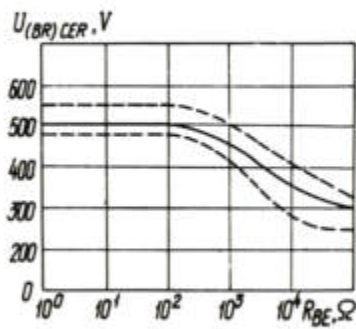
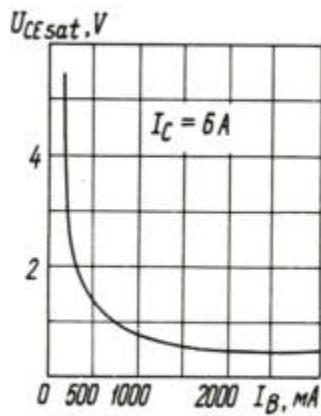
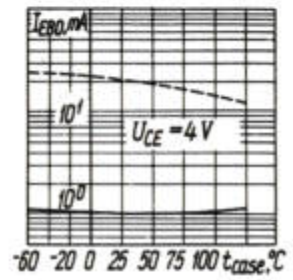
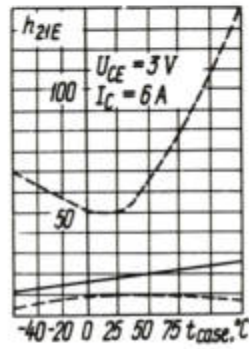
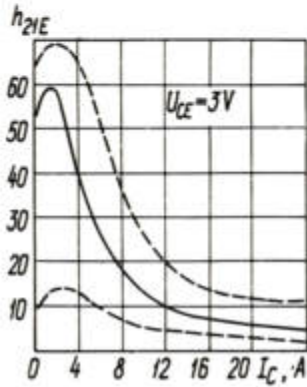


ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95** % РАЗБРОСА
SPREAD

KT844A



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95** / **0** РАЗБРОСА
SPREAD